04 0074635 APR 1514

(54) DETECTING METHOD FOR ETCHING DEPTH

(11) 59-74635 (A)

(43) 27.4.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 57-184576

(22) 22.10.1982

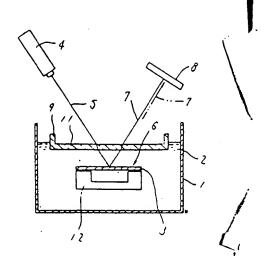
(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) NORIHIRO YAZAKI(1)

(51) Int. Cl3. H01L21/306

PURPOSE: To detect etching depth automatically and accurately by radiating laser lights to the etching surface of a material to be etched and detecting etch-

ing depth by utilizing the reflected light.

CONSTITUTION: The material to be etched 3 set on a jig 12 is entered in an etching liquid 2 received in an etching tank 1, and laser lights 5 from a laser oscillator 4 are radiated to the etching surface 6 of the material to be etched 3 from an oblique upper section. Reflected laser lights 7 reflected by the etching surface 6 are detected by a sensor 8 set up to the upper section of the etching tank 1. A glass box 9 is arranged to the surface of the etching liquid 2 to prevent the troubling of the etching surface 6, and the depth of the etching surface is detected more accurately by the sensor 8. The depth of etching is accurately detected automatically by the sensor 8 by utilizing reflected light from the etching surface 6.



216/05

Wow

Į,

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭59-74635

Sylnt. Cl.3 H 01 L 21/306 識別記号

庁内整理番号 J 8223-5F 愈公開 昭和59年(1984) 4 月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## ❸エッチング深さ検出方法

20特

願 昭57-184576

❷出

願 昭57(1982)10月22日

砂発 明 者

者 矢崎憲弘 髙崎市西横手町111番地株式会

社日立製作所髙崎工場内

位発 明 者 佐藤昭彦

高崎市西横手町111番地株式会 社日立製作所高崎工場内

引出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

组代 理 人 弁理士 薄田利幸

y) 10 T

。発明の名称 エッチングほき検出方法

## 特許請求の顛開

1. 彼エッチング物のエッチング耐にレーザー光を投射し、その反射光を利用してエッチング深さを検出することを特徴とするエッチング深さ検出方法。

## 発明の詳細な説明

本発明はエッチング架さ他出方法に関する。光 泉子(半導体レーザーや赤外発光ダイオードなど) ヤファクシミリ用半導体集駅回路装置(1C)の ように高い品質を要求される製品を製造する場合、 その製造工程において高い精度が要求される。

 る・

しかし、この方法は作業者の主観によることと、 作業による疲れ等によってエッチング程度が低くなるおそれもあるとともに、目視確認する作業人員 を必要とするためエッチングコストが高くなる欠 点がある。また、この方法では、定量的なエッチング深さの検出はできない。一方最近は、上述の エッチング作業を機械を用いて自動化しようとする動きがありこの場合に自動的なエッチング探さ 検出が不可欠になる。

したがって、本発明の目的は自動的にかつ正確 にエッチング深さを検出することのできるエッチ ング深さ検出方法を提供することにある。

このような目的を達成するために本発明は、エッチング液中の被エッチング物のエッチング面に対してエッチング液に接触するガラスを介してレーザー光を斜めから投射し、その反射光の反射位 仮の変動を検出することによってエッチング探さ を検出するものであって、以下実施例により本発 明を説明する。 図面は本発明の一実施例によるエッチング保さ検 出方法を示す概略図である。

この火施例では、エッチング們1に収容したエ ッチング液2中に、治具12上にセットされた被 エッチング物(半海体ウエハー)3を入れた後、 この被エッチング物3のエッチング面にレーザー 発 **収器4から出射されるレーザー光5を投射する。レ** - ザー光5はエッチング面6に対して斜め上方から投 射する。そして、エッチング面6で 反射した反射 レ -ザー光1をエッチング桁1の上方に配設したセン サー8によって検出する。また、エッチング液面 が 放立つと反射レーザー光1によるエッチング架さの 検出ができなくなることから、エッチング液面に はガラス板9が取り付けられている。なお、この ガラス板は部分的に設けられており半退体ウェハ - の出し入れにはさしつかえない。 ガラス板9は 周壁10でガラス板 9 内へのエッチング液 2 の流 入を防止している。また、ガラス仮9の底はフラ ットなガラス11で形成されている。したがって、 レーザー光 5 および反射レーザー光 7 はこのガラ

を図ることができる。

本発明は前記実施例に限定されるものではない。 エッチ放中の被エッチング物は多少の揺れ、ずれ などにより位置が移動する可能性があり、この場合に反射レーザー光の位置もずれてしまい測定に 誤差が生じる。このことを防止するために被エッチング物の囚定部に結準光を当て、これを反射させ 飲み取る事により位置変位を 翻定し、これを考 度して被エッチング物よりの反射光の変位を補正 することによりエッチ及さの検出精度をさらに向 上させることができる。

なお、本方式以外に市販の調長システムを用い、 真上より波長の決まったレーザー光を被エッチング物にあてエッテングされた箇所とされない簡所 からの反射光の干砂を利用してエッチング深さを 調定することも可能である。

以上のように、本苑明によれば、自動的にかつ 正確にエッチング深さを検出することのできるエッテング深さ検出方法を提供することができると ともに、エッチング作業の自動化が可能となる。 ス11を透過する。 前配センサー 8は間体損像器子をマトリックス状に配置した構造あるいはラインセンサ部からなり、反射レーサー光7の高さ変化を検出するようになっている。

このようなエッチング深さ検出方法では、エッチングが進行するにつれてレーザー光5の反射位限が低くなるため、センサー8に進む反射レーザー光7の位置も低くなり、エッチング探さを検出することができる。図中エッチング終点時の反射レーザー光7を二点鎖線で示す。この方法ではエッチング量は1μmの精度まで検出することができる。

この実施例では、センサー8によって自動的に エッチング深さを定量的に検出することができる とともに、容報等とセンサーを連動させておくこ とによって、エッチング終点に至った時点を自動 的に検出し作業者に知らせることができる。

また、この実施例によればエッチング終点を目 視で検出する作業者も不要となり、作業人員の低 被化が図れることから、エッチングコストの軽減

## 図面の簡単な説明

図面は本発明の一実施例によるエッチングなさ 検出方法を示す領略図である。

1…エッチング補、2…エッチング液、3…被エッチング物、4…レーザー発掘器、5…レーザー光、6…被エッチング面、7…反射レーザー光、8…センサー、9…ガラス箱、1.1…ガラス、12…前島。

代理人 弁理士 課 田 利 桑。

